FLÜSSIGKRISTALLINES MEDIUM ENTHALTEND FLUORIERTE INDANVERBINDUGNEN

Die Erfindung betrifft ein flüssigkristallines Medium auf der Basis eines Gemisches von polaren Verbindungen mit negativer dielektrischer Anisotropie, welches mindestens eine Verbindung der Formel I,

10
$$R^{11}-(A^1-Z^1)_m \longrightarrow O$$
 $(Z^2-A^2)_n-R^{12}$

worin

25

30

35

jeweils unabhängig voneinander H, einen unsubstituierten, einen einfach durch CN oder CF₃ oder mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl- oder Alkenylrest mit bis zu 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen durch –O-, -S-, —————, -C≡C-, -OC-O- oder -O-CO- so ersetzt sein können, dass O-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind,

A¹ und A² jeweils unabhängig voneinander

- a) einen 1,4-Cyclohexenylen- oder 1,4-Cyclohexylenrest, worin eine oder zwei nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -O- oder -S- ersetzt sein können,
- b) einen 1,4-Phenylenrest, worin eine oder zwei CH-Gruppen durch N ersetzt sein können,
- c) einen Rest aus der Gruppe Piperidin-1,4-diyl-, 1,4-Bicyclo[2,2,2]-octylen-, einen Naphthalin-2,6-diyl, Decahydronaphthalin-2,6-diyl, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2,6-diyl, Phenanthren-2,7-diyl, Fluoren-2,7-diyl,

wobei die Reste a), b) und c) ein oder mehrfach durch Halogenatome substituiert sein können,

- jeweils unabhängig voneinander -CO-O-, -O-CO-, -CF₂O-, -OCF₂-, -CH₂O-, -OCH₂-, -CH₂CH₂-, -(CH₂)₄-, -C₂F₄-, -CH₂CF₂-, -CF₂CH₂-, -CF=CF-, -CH=CF-, -CF=CH-, -C=C- oder eine Einfachbindung, und
- 10 m und n jeweils unabhängig voneinander 0, 1 oder 2, wobei m + n ≥ 1

bedeuten,

15 enthält.

Derartige Medien sind insbesondere für elektrooptische Anzeigen mit einer Aktivmatrix-Addressierung basierend auf dem ECB-Effekt sowie für IPS-Anzeigen (In plane switching) zu verwenden.

Das Prinzip der elektrisch kontrollierten Doppelbrechung, der ECB-Effekt (electrically controlled birefringence) oder auch DAP-Effekt (Deformation aufgerichteter Phasen) wurde erstmals 1971 beschrieben (M.F. Schieckel und K. Fahrenschon, "Deformation of nematic liquid crystals with vertical orientation in electrical fields", Appl. Phys. Lett. 19 (1971), 3912). Es folgten Arbeiten von J.F. Kahn (Appl. Phys. Lett. 20 (1972), 1193) und G. Labrunie und J. Robert (J. Appl. Phys. 44 (1973), 4869).

Die Arbeiten von J. Robert und F. Clerc (SID 80 Digest Techn. Papers (1980), 30), J. Duchene (Displays 7 (1986), 3) und H. Schad (SID 82 Digest Techn. Papers (1982), 244) haben gezeigt, dass flüssigkristalline Phasen hohe Werte für das Verhältnis der elastischen Konstanten K₃/K₁, hohe Werte für die optische Anisotropie Δn und Werte für die dielektrische Anisotropie Δε von -0,5 bis -5 aufweisen müssen, um für hochinformative Anzeigeelemente basierend auf dem ECB-Effekt eingesetzt werden zu

10

20

25

30

35

können. Auf dem ECB-Effekt basierende elektrooptische Anzeigeelemente weisen eine homöotrope Randorientierung auf. Auch bei Anzeigen, die den sogenannten IPS-Effekt verwenden, können dielektrisch negative Flüsigkristallmedien zum Einsatz kommen.

Für die technische Anwendung dieses Effektes in elektrooptischen Anzeigeelementen werden FK-Phasen benötigt, die einer Vielzahl von Anforderungen genügen müssen. Besonders wichtig sind hier die chemische Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Luft und physikalischen Einflüssen wie Wärme, Strahlung im infraroten, sichtbaren und ultravioletten Bereich und elektrische Gleich- und Wechselfelder.

Ferner wird von technisch verwendbaren FK-Phasen eine flüssigkristalline
Mesophase in einem geeigneten Temperaturbereich und eine niedrige
Viskosität gefordert.

In keiner der bisher bekannten Reihen von Verbindungen mit flüssigkristalliner Mesophase gibt es eine Einzelverbindung, die allen diesen Erfordernissen entspricht. Es werden daher in der Regel Mischungen von zwei bis 25, vorzugsweise drei bis 18, Verbindungen hergestellt, um als FK-Phasen verwendbare Substanzen zu erhalten. Optimale Phasen konnten jedoch auf diese Weise nicht leicht hergestellt werden, da bisher keine Flüssigkristallmaterialien mit deutlich negativer dielektrischer Anisotropie und ausreichender Langzeitstabilität zur Verfügung standen.

Matrix-Flüssigkristallanzeigen (MFK-Anzeigen) sind bekannt. Als nichtlineare Elemente zur individuellen Schaltung der einzelnen Bildpunkte können beispielsweise aktive Elemente (d.h. Transistoren) verwendet werden. Man spricht dann von einer "aktiven Matrix", wobei man zwei Typen unterscheiden kann:

- MOS (Metal Oxide Semiconductor)-Transistoren auf Silizium-Wafer als Substrat.
- 2. Dünnfilm-Transistoren (TFT) auf einer Glasplatte als Substrat.

Bei Typ 1 wird als elektrooptischer Effekt üblicherweise die dynamische Streuung oder der Guest-Host-Effekt verwendet. Die Verwendung von einkristallinem Silizium als Substratmaterial beschränkt die Displaygröße, da auch die modulartige Zusammensetzung verschiedener Teildisplays an den Stößen zu Problemen führt.

Bei dem aussichtsreicheren Typ 2, welcher bevorzugt ist, wird als elektrooptischer Effekt üblicherweise der TN-Effekt verwendet.

10

5

Man unterscheidet zwei Technologien: TFT's aus Verbindungshalbleitern wie z.B. CdSe oder TFT's auf der Basis von polykristallinem oder amorphem Silizium. An letzterer Technologie wird weltweit mit großer Intensität gearbeitet.

15

20

Die TFT-Matrix ist auf der Innenseite der einen Glasplatte der Anzeige aufgebracht, während die andere Glasplatte auf der Innenseite die transparente Gegenelektrode trägt. Im Vergleich zu der Größe der Bildpunkt-Elektrode ist der TFT sehr klein und stört das Bild praktisch nicht. Diese Technologie kann auch für voll farbtaugliche Bilddarstellungen erweitert werden, wobei ein Mosaik von roten, grünen und blauen Filtern derart angeordnet ist, dass je ein Filterelement einem schaltbaren Bildelement gegenüber liegt.

25

Die bisher bekannten TFT-Anzeigen arbeiten üblicherweise als TN-Zellen mit gekreuzten Polaristoren in Transmission und sind von hinten beleuchtet.

30

Der Begriff MFK-Anzeigen umfasst hier jedes Matrix-Display mit integrierten nichtlinearen Elementen, d.h. neben der aktiven Matrix auch Anzeigen mit passiven Elementen wie Varistoren oder Dioden (MIM = Metall-Isolator-Metall).

35

Derartige MFK-Anzeigen eignen sich insbesondere für TV-Anwendungen (z.B. Taschenfernseher) oder für hochinformative Displays in Automobiloder Flugzeugbau. Neben Problemen hinsichtlich der Winkelabhängigkeit des Kontrastes und der Schaltzeiten resultieren bei MFK-Anzeigen

Schwierigkeiten bedingt durch einen nicht ausreichend hohen spezifischen Widerstand der Flüssigkristallmischungen [TOGASHI, S., SEKIGUCHI, K., TANABE, H., YAMAMOTO, E., SORIMACHI, K., TAJIMA, E.,

- WATANABE, H., SHIMIZU, H., Proc. Eurodisplay 84, Sept. 1984: A 210-288 Matrix LCD Controlled by Double Stage Diode Rings, p. 141 ff, Paris; STROMER, M., Proc. Eurodisplay 84, Sept. 1984: Design of Thin Film Transistors for Matrix Adressing of Television Liquid Crystal Displays, p. 145 ff, Paris]. Mit abnehmendem Widerstand verschlechtert sich der
- Kontrast einer MFK-Anzeige. Da der spezifische Widerstand der Flüssigkristallmischung durch Wechselwirkung mit den inneren Oberflächen der Anzeige im allgemeinen über die Lebenszeit einer MFK-Anzeige abnimmt, ist ein hoher (Anfangs)-Widerstand sehr wichtig für Anzeigen die akzeptable Widerstandswerte über eine lange Betriebsdauer aufweisen müssen.

Der Nachteil der bisher bekannten MFK-TN-Anzeigen beruht in ihrem vergleichsweise niedrigen Kontrast, der relativ hohen Blickwinkelabhängigkeit und der Schwierigkeit in diesen Anzeigen Graustufen zu erzeugen.

- Es besteht somit immer noch ein großer Bedarf nach MFK-Anzeigen mit sehr hohem spezifischen Widerstand bei gleichzeitig großem Arbeitstemperaturbereich, kurzen Schaltzeiten und niedriger Schwellenspannung, mit deren Hilfe verschiedene Graustufen erzeugt werden können.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, MFK-Anzeigen welche auf dem ECB- oder auf dem IPS-Effekt beruhen, bereitzustellen, die die oben angegebenen Nachteile nicht oder nur in geringerem Maße und gleichzeitig sehr hohe spezifische Widerstände aufweisen.
- Es wurde nun gefunden, dass diese Aufgabe gelöst werden kann, wenn man in diesen Anzeigeelementen nematische Flüssigkristallmischungen verwendet, die mindestens eine Verbindung der Formel I enthalten.
- Gegenstand der Erfindung ist somit ein flüssigkristallines Medium auf der Basis eines Gemisches von polaren Verbindungen mit negativer dielektrischer Anisotropie, welches mindestens eine Verbindung der Formel I enthält.

10

Verbindungen der Formel I sind z.B. aus der EP 0 637 585 A1 bekannt. Die im Stand der Technik beschriebenen flüssigkristallinen Mischungen sind ausschließlich für ferroelektrische Anwendungen gedacht. Die Verwendung von fluorierten Indanen für ECB- oder IPS-Anzeigen ist nicht bekannt.

Die erfindungsgemäßen Mischungen zeigen sehr günstige Werte für die kapazitive Schwelle, relativ hohe Werte für die Holding Ratio und gleichzeitig eine sehr gute Tieftemperaturstabilität sowie sehr geringe Rotationsviskositäten.

Einige bevorzugte Ausführungsformen werden im folgenden genannt:

15 a) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formeln IIA und/oder IIB enthält,

$$R^{2} \xrightarrow{F} O \xrightarrow{F} (O)C_{v}H_{2v+1}$$
IIA

worin

R² die Bedeutung von R¹¹ hat,

p 1 oder 2, und

v 1 bis 6

35 bedeutet.

b) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formel III enthält,

 $R^{31} - R^{32}$

worin

10 R³¹ und R³² jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkyl-, Alkylalkoxy- oder Alkoxyrest mit bis zu 12 C-Atomen, und

bedeuten.

25

- c) Flüssigkristallines Medium, welches ein, zwei, drei, vier oder mehr, vorzugsweise ein oder zwei Verbindungen der Formel I enthält.
 - d) Flüssigkristallines Medium, worin R¹¹ in Formel I vorzugsweise folgende Bedeutungen haben: geradkettiges Alkyl, Vinyl, 1E-Alkenyl oder 3-Alkenyl.

Falls R¹¹ und/oder R¹² Alkenyl bedeuten, so ist es vorzugsweise CH₂=CH, CH₃-CH=CH, C₃H₇-CH=CH, CH₂=CH-C₂H₅ oder CH₃-CH=CH-C₂H₅.

- R¹² bedeutet vorzugsweise H oder geradkettiges Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen, insbesondere Methyl, Ethyl oder Propyl.
- e) Flüssigkristallines Medium, wobei der Anteil an Verbindungen der Formel I im Gesamtgemisch mindestens 5 Gew.%, vorzugsweise mindestens 10 Gew.%, beträgt.

- f) Flüssigkristallines Medium, wobei der Anteil an Verbindungen der Formeln IIA und/oder IIB im Gesamtgemisch mindestens 20 Gew.-% beträgt.
- g) Flüssigkristallines Medium, wobei der Anteil den Verbindungen der Formel III im Gesamtgemisch mindestens 5 Gew.-% beträgt.
- h) Flüssigkristallines Medium, welches mindestens eine Verbindung ausgewählt aus den Teilformeln I1 bis I36 enthält:

5 .

$$R^{11}$$
 O $I2$

20

25

$$R^{11}$$
 O F F F F

30

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F F$$
110

$$R^{11}$$
 O
 F
 F
 F
 $Alkyl$
 $I13$

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F$$

$$114$$

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F$$
116

$$R^{11} \longrightarrow F F F$$
118

$$R^{11}$$
 O Alkyl 119

$$R^{11}$$
 O 120

$$R^{11} \longrightarrow O \longrightarrow Alkyl$$
10 | F F F F

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F F$$

$$122$$

$$R^{11} \longrightarrow O \longrightarrow Alkyl$$
 123

$$R^{11} \xrightarrow{O} \xrightarrow{Alkyl} 127$$

$$R^{11} \xrightarrow{O} \xrightarrow{F} \xrightarrow{F} \xrightarrow{E} 128$$

$$R^{11} \longrightarrow O \longrightarrow Alkyl$$
 129

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F F$$
130

$$R^{11} \longrightarrow O \longrightarrow Alkyl$$
 131

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F F$$
132

$$R^{11} \longrightarrow O \longrightarrow Alkyl \qquad I33$$

$$R^{11} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0$$

$$F F F F$$
134

$$R^{11} \longrightarrow Alkyl$$
 135

Besonders bevorzugte Medien enthalten eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen der Formeln

30

20

25

i) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine Verbindung ausgewählt aus den Formeln IIIa bis IIIf enthält:

35 Alkyl und

Alkyl* jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen, und

Alkenyl und

Alkenyl*

jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkenylrest mit 2-6 C-Atomen

5

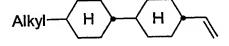
bedeuten.

Vorzugsweise enthält das erfindungsgemäße Medium mindestens eine Verbindung der Formel IIIa, Formel IIIb und/oder Formel IIIe.

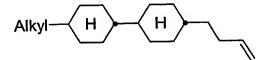
10

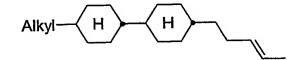
Besonders bevorzugte Verbindungen der Formeln IIIe und IIIf werden nachfolgend genannt:

15

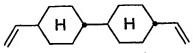


20

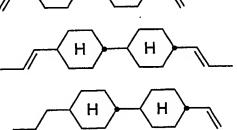




25



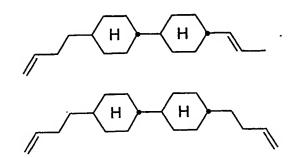
30



15

20

25



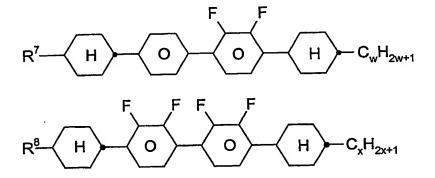
j) Flüssigkristallines Medium, welches im wesentlichen aus:

5-30 Gew.-% einer oder mehrerer Verbindungen der Formel I und

20-70 Gew.-% einer oder mehrerer Verbindungen der Formeln IIA und/oder IIB

besteht.

k) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine oder mehrere Vierkernverbindungen der Formeln,



30 worin

R⁷ und R⁸ jeweils unabhängig voneinander eine der in Anspruch 1 für R¹ angegebenen Bedeutung haben, und

w und x jeweils unabhängig voneinander 1 bis 6

bedeuten,

enthält.

5

I) Flüssigkristallines Medium, welches zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formeln

10
$$R^{13} \longrightarrow H \longrightarrow O \longrightarrow (CH_2)_z - O - C_m H_{2m+1}$$

$$R^{14} \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow (O) - C_m H_{2m+1}$$

$$R^{E} \longrightarrow H \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow O$$

$$R^{15} \longrightarrow H \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow O$$

$$R^{16} \longrightarrow H \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow O$$

$$R^{16} \longrightarrow H \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow O$$

$$R^{16} \longrightarrow H \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow O$$

35

.30

$$R^{18} = H - OCF_{2} - O - (O) - C_{m}H_{2m+1}$$

$$R^{19} = H - O - CF_{2}O - O - (O) - C_{m}H_{2m+1}$$

$$R^{20} = H - O - OCF_{2} - O - (O) - C_{m}H_{2m+1}$$

$$R^{20} = H - CF_{2}O - O - (O) - C_{m}H_{2m+1}$$

$$R^{21} = H - CF_{2}O - O - (O) - C_{m}H_{2m+1}$$

$$R^{22} = H - CF_{2}O - O - (O) - C_{m}H_{2m+1}$$

$$R^{23} = H - CF_{2}O - O - (O) - C_{m}H_{2m+1}$$

$$R^{24} = H - CF_{2}O - O - (O) - CF_{m}H_{2m+1}$$

$$R^{25} = H - CF_{2}O - O - OCH_{2m+1}$$

$$R^{25} = H - CF_{2}O - O - OCH_{2m+1}$$

20

35

15 enthält,

worin R^{13} - R^{28} jeweils unabhängig voneinander, die für R^{11} angegebenen Bedeutungen haben, und z und m jeweils unabhängig voneinander 1-6 bedeuten. R^E bedeutet H, CH_3 , C_2H_5 oder n- C_3H_7 .

m) Flüssigkristallines Medium enthaltend zusätzlich ein oder mehrere Verbindungen der Formeln,

worin R Alkyl, Alkenyl, Alkoxy, Alkylalkoxy, Alkenyloxy mit 1 bzw. 2 bis 6 C-Atomen bedeutet und Alkenyl die oben angegebene Bedeutung hat.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine elektrooptische Anzeige mit einer Aktivmatrix-Adressierung basierend auf dem ECB-Effekt, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Dielektrikum ein flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1 bis 9 enthält.

Vorzugsweise weist die Flüssigkristallmischung einen nematischen Phasenbereich von mindestens 60 K und eine Fließviskosität v_{20} von maximal 30 mm² · s⁻¹ bei 20 °C auf.

Die erfindungsgemäße Flüssigkristallmischung weist ein $\Delta\epsilon$ von etwa -0,5 bis -8,0, insbesondere von etwa -3,0 bis -6,0 auf, wobei $\Delta\epsilon$ die dielektrische Anisotropie bedeutet. Die Rotationsviskosität γ_1 ist vorzugsweise < 150 mPa·s, insbesondere < 140 mPa·s.

Die Doppelbrechung Δn in der Flüssigkristallmischung liegt, in der Regel, zwischen 0,07 und 0,16, vorzugsweise zwischen 0,08 und 0,11.

Die erfindungsgemäßen Mischungen sind für alle VA-TFT-Anwendungen geeignet, wie z.B. MVA, PVA, ASV. Weiterhin sind sie für IPS- und PALC-Anwendungen mit negativem Δε geeignet.

Die Verbindungen der Formel I können beispielsweise wie folgt hergestellt werden:

30

10

Schema 1

5
$$R^{12}-(A^{2}-Z^{2})_{n} F R^{12}-(A^{2}-Z^{2})_{n} F R^{12}-(A^{2}-Z^{$$

- Die nematischen Flüssigkristallmischungen in den erfindungsgemäßen Anzeigen enthalten in der Regel zwei Komponenten A und B, die ihrerseits aus einer oder mehreren Einzelverbindungen bestehen.
- Die Komponente A weist eine deutlich negative dielektrische Anisotropie auf und verleiht der nematischen Phase eine dielektrische Anisotropie von < -0,3. Sie enthält bevorzugt Verbindungen der Formeln I, IIA und/oder IIB.</p>

Der Anteil der Komponente A liegt vorzugsweise zwischen 45 und 100 %, insbesondere zwischen 60 und 100 %.

Für Komponente A wird vorzugsweise eine (oder mehrere) Einzelverbindung(en) gewählt, die einen Wert von $\Delta\epsilon \le -0.8$ haben. Dieser Wert muss umso negativer sein, je kleiner der Anteil A an der Gesamtmischung ist.

5

Die Komponente B weist eine ausgeprägte Nematogenität und eine Fließviskosität von nicht mehr als 30 mm² s⁻¹, vorzugsweise nicht mehr als 25 mm²·s⁻¹, bei 20 °C auf.

10

Besonders bevorzugte Einzelverbindungen der Komponente B sind extrem niedrig viskose nematische Flüssigkristalle mit einer Fließviskosität von nicht mehr als 18, vorzugsweise nicht mehr als 12 mm² s⁻¹, bei 20 °C.

15

Komponente B ist monotrop oder enantiotrop nematisch, weist keine smektischen Phasen auf und kann in Flüssigkristallmischungen das Auftreten von smektischen Phasen bis zu sehr tiefen Temperaturen verhindern. Versetzt man beispielsweise eine smektische Flüssigkristallmischung mit jeweils verschiedenen Materialien mit hoher Nematogenität, so kann durch den erzielten Grad der Unterdrückung smektischer Phasen die Nematogenität dieser Materialien verglichen werden.

20

Dem Fachmann sind aus der Literatur eine Vielzahl geeigneter Materialien bekannt. Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel III.

25

Daneben können diese Flüssigkristallphasen auch mehr als 18 Komponenten, vorzugsweise 18 bis 25 Komponenten, enthalten.

Vorzugsweise enthalten die Phasen 4 bis 15, insbesondere 5 bis 12, Verbindungen der Formeln I, IIA und/oder IIB und optional III.

30

Neben Verbindungen der Formeln I, IIA und/oder IIB und III können auch noch andere Bestandteile zugegen sein, z. B. in einer Menge von bis zu 45 % der Gesamtmischung, vorzugsweise jedoch bis zu 35 %, insbesondere bis zu 10 %.

10

20

Die anderen Bestandteile werden vorzugsweise ausgewählt aus den nematischen oder nematogenen Substanzen, insbesondere den bekannten Substanzen, aus den Klassen der Azoxybenzole, Benzylidenaniline, Biphenyle, Terphenyle, Phenyl oder Cyclohexylbenzoate, Cyclohexan-carbonsäurephenyl- oder -cyclohexylester, Phenylcyclohexane, Cyclohexylbiphenyle, Cyclohexylcyclohexane, Cyclohexylnaphthaline, 1,4-Bis-cyclohexylbiphenyle oder Cylohexylpyrimidine, Phenyl- oder Cyclohexyldioxane, gegebenenfalls halogenierten Stilbene, Benzylphenylether, Tolane und substituierten Zimtsäuren.

Die wichtigsten als Bestandteile derartiger Flüssigkristallphasen in Frage kommenden Verbindungen lassen sich durch die Formel IV charakterisieren,

15
$$R^9$$
-L-G-E- R^{10} IV

worin L und E je ein carbo- oder heterocyclisches Ringsystem aus der aus 1,4-disubstituierten Benzol- und Cyclohexanringen, 4,4'-disubstituierten Biphenyl-, Phenylcyclohexan- und Cyclohexylcyclohexansystemen, 2,5-disubstituierten Pyrimidin- und 1,3-Dioxanringen, 2,6-disubstituierten Naphthalin, Di- und Tetrahydronaphthalin, Chinazolin und Tetrahydrochinazolin gebildeten Gruppe,

10

oder eine C-C-Einfachbindung, Q Halogen, vorzugsweise Chlor, oder -CN, und R⁹ und R¹⁰ jeweils Alkyl, Alkenyl, Alkoxy, Alkanoyloxy oder Alkoxycarbonyloxy mit bis zu 18, vorzugsweise bis zu 8 Kohlenstoffatomen, oder einer dieser Reste auch CN, NC, NO₂, NCS, CF₃, OCF₃, F, Cl oder Br bedeuten.

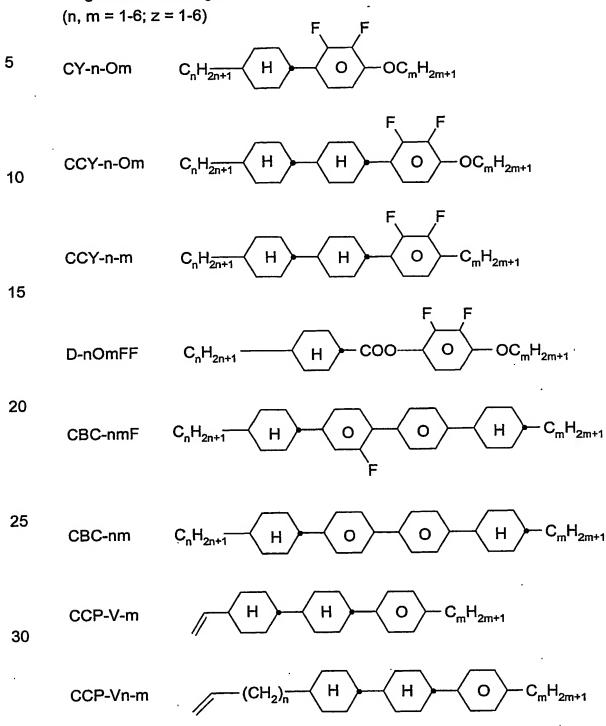
Bei den meisten dieser Verbindungen sind R⁹ und R¹⁰ voneinander verschieden, wobei einer dieser Reste meist eine Alkyl- oder Alkoxygruppe ist. Auch andere Varianten der vorgesehenen Substituenten sind gebräuchlich. Viele solcher Substanzen oder auch Gemische davon sind im Handel erhältlich. Alle diese Substanzen sind nach literaturbekannten Methoden herstellbar.

- Es versteht sich für den Fachmann von selbst, dass die erfindungsgemäße VA-, IPS- oder PALC-Mischung auch Verbindungen enthalten kann, worin beispielsweise H, N, O, Cl, F durch die entsprechenden Isotope ersetzt sind.
- Der Aufbau der erfindungsgemäßen Flüssigkristallanzeigen entspricht der üblichen Geometrie, wie sie z.B. in EP-OS 0 240 379, beschrieben wird.

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne sie zu begrenzen. Vor- und nachstehend bedeuten Prozentangaben Gewichtsprozent; alle Temperaturen sind in Grad Celsius angegeben.

Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäßen Mischungen neben den Verbindungen der Formeln I eine oder mehrere Verbindungen der nachfolgend genannten Verbindungen.

Folgende Abkürzungen werden verwendet:



5

CH-nm

$$C_nH_{2n+1}$$
 H
 H
 COO
 H
 C_mH_{2n}
 C_mH_{2n+1}
 C_mH_{2n+1}

10

 $CVY-V-n$
 CVY

Die Herstellung der erfindungsgemäß verwendbaren Flüssigkristallmischungen erfolgt in an sich üblicher Weise. In der Regel wird die gewünschte Menge der in geringerer Menge verwendeten Komponenten in der den Hauptbestandteil ausmachenden Komponenten gelöst, zweckmäßig bei erhöhter Temperatur. Es ist auch möglich, Lösungen der Komponenten in einem organischen Lösungsmittel, z.B. in Aceton, Chloroform oder Methanol, zu mischen und das Lösungsmittel nach Durchmischung wieder zu entfernen, beispielsweise durch Destillation.

10

5

Die Dielektrika können auch weitere, dem Fachmann bekannte und in der Literatur beschriebene Zusätze, wie z.B. UV-Absorber, Antioxidantien, Radikalfänger, enthalten. Beispielsweise können 0-15 % pleochroitische Farbstoffe, Stabilisatoren oder chirale Dotierstoffe zugesetzt werden.

15

Beispielsweise können 0-15 % pleochroitische Farbstoffe zugesetzt werden, ferner Leitsalze, vorzugsweise Ethyldimethyldodecylammonium-4-hexoxybenzoat, Tetrabutylammoniumtetraphenylboranat oder Komplexsalze von Kronenethern (vgl. z.B. Haller et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst. Band 24, Seiten 249- 258 (1973)) zur Verbesserung der Leitfähigkeit oder Substanzen zur Veränderung der dielektrischen Anisotropie, der Viskosität und/oder der Orientierung der nematischen Phasen. Derartige Substanzen sind z. B. in den DE-OS 22 09 127, 22 40 864, 23 21 632, 23 38 281, 24 50 088, 26 37 430 und 28 53 728 beschrieben.

25

20

In der Tabelle A werden mögliche Dotierstoffe angegeben, die den erfindungsgemäßen Mischungen zugesetzt werden können. Sofern die Mischungen einen Dotierstoff enthalten, wird er in Mengen von 0,01-4 Gew.%, vorzugsweise 0,1-1,0 Gew.%, eingesetzt.

Tabelle A

C 15 CB 15

CM 21

$$C_{e}H_{13}O \xrightarrow{O} O \xrightarrow{O} O \xrightarrow{\overset{\star}{C}H-C_{e}H_{13}}$$

20 **R/S-811**

CM 44

$$C_{5}H_{11} \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow C_{8}H_{17}O \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow O \longrightarrow C_{2}H_{5}$$

CM 45 CM 47

CN

10
$$C_5H_{11}$$
 H O COO COO O H C_5H_{11}

R/S-1011

15
$$C_3H_7$$
— H — H — O
 F
 C_6H_{13}
 C_9H_7 — C_6H_{13}

R/S-2011

$$C_3H_7$$
 H
 H
 O
 O
 O

R/S-3011

$$C_{5}H_{11} \xrightarrow{O} \xrightarrow{O} \xrightarrow{F} \overset{C}{\underset{F}{C}}H_{3}$$

30 R/S-4011

R/S-5011

Stabilisatoren, die beispielsweise den erfindungsgemäßen Mischungen zugesetzt werden können, werden nachfolgend in Tabelle B genannt.

5 <u>Tabelle B</u> (n = 1-12)

10

$$C_nH_{2n+1}$$
 O OH

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne sie zu begrenzen. Vor- und nachstehend bedeuten

V_o Schwellenspannung, kapazitiv [V] bei 20 °C
 Δn die optische Anisotropie gemessen bei 20 °C und 589 nm
 Δε die dielektrische Anisotropie bei 20 °C und 1 kHz
 35 cp. Klärpunkt [°C]

	γ1	Rotationsviskosität gemessen bei 20 °C [mPa·s]					
5	LTS	Low temperature stability, bestimmt in Testzellen					
0	Die zur Messung der Schwellenspannung verwendete Anzeige weist zweinnerallele Trägerplatten im Abstand von 20 µm und Elektrodenschichten mit darüberliegenden Orientierungsschichten aus SE-1211 (Nissan Chemicals) auf den Innenseiten der Trägerplatten auf, welche						
10	eine homöo	rope Orientierung der Flüssigkristalle bewirken.					
15							
20	·						
25		· .					
30							
35							

<u>Mischungsbeispiele</u>

Vergleichsbeispiel 1

5				
J	CY-3-O2	19,0 %	Klärpunkt [°C]:	74,5
	CY-5-O2	12,0 %	∆n [589 nm, 20 °C]:	+0,0815
	CCY-3-03	7,0 %	ε _{II} [1 kHz, 20 °C]:	3,6
	CCY-4-02	7,0 %	Δε [1 kHz, 20 °C]:	-3,6
10	CPY-2-02	7,0 %	γ₁ [mPa⋅s, 20 °C]:	102
	CC-5-V	20,0 %	V ₀ [V]	2,12
	CC-3-V1	12,0 %	LTS bei -30 °C:	nematisch > 1000 h
	CCP-V-1	5,0 %		
45	CCH-35	5,0 %		
15	C ₃ H ₇ —()—()0)_F	6,0 %		
	F F F			
	Deleviol M4			
20	Beispiel M1			
	CY-3-02	10,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,0
	CY-5-02	11,00 %	Δε [589 nm, 20 °C]:	-3,6
	CCY-3-02	8,00 %	γ₁ [mPa⋅s, 20 °C]:	98
	CCY-4-02	7,00 %	V ₀ [V]	2,11
25	CPY-2-02	7,00 %		
	CC-5-V	19,00 %		
	CC-3-V1	12,00 %		
	CCP-V-1	6,00 %		
	CCH-35	6,00 %		
30	C ₃ H ₇ —(H)—(O)	7,00 %		
	FF F			
		7,00 %		
25	FF F CH ₃			

	Beispiel M2			
	CY-3-02	11,00 %	Klärpunkt [°C]:	+84,5
5	CY-5-02	12,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	+0,0817
	CCY-3-02	8,00 %	ε _{ll} [1 kHz, 20 °C]:	3,5
	CCY-3-03	12,00 %	Δε [1 kHz, 20 °C]:	-3,9
	CCY-4-02	12,00 %	γ ₁ [mPa⋅s, 20 °C]:	129
	CPY-2-02	3,00 %	V ₀ [V]	2,17
10	CC-5-V	20,00 %		
	CC-3-V1	12,00 %		•
	CCH-35	4,00 %		
	C ₃ H ₇ —(H)—(10)	6,00 %		
	F F E CH ₃			
15	•			
	Beispiel M3			
	CY-3-04	12,00 %	Klärpunkt [°C]:	75,0
	CY-5-02	12,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,0948
20	CY-5-04	12,00 %	Δε [1 kHz, 20 °C]:	-4,8
	CCY-3-02	12,00 %	γ₁ [mPa⋅s, 20 °C]:	178
	CCY-4-02	8,00 %	V ₀ [V]	1,84
	CPY-2-02	5,00 %		
05	CPY-3-02	6,00 %		
25	CC-5-V	10,00 %		
	CC-3-V1	6,00 %		
	BCH-32	8,00 %		
30	C ₃ H ₇ —H—O FFFF	9,00 %	·	

	•				
-		~1	\sim		1/1
<u>Be</u>	15	L H	=	i iv	-
		_	=		• •

	CY-3-04	16,00 %	Klärpunkt [°C]:	74,0
5	CY-5-02	6,00 %	∆n [589 nm, 20 °C]:	0,0960
	CY-5-04	10,00 %	Δε [1 kHz, 20 °C]:	-4,8
	\sim	8,00 %	γ₁ [mPa⋅s, 20 °C]:	171
	C ₃ H ₇ — H		V ₀ [V]:	1,85
	F F	0.00.0/		
10	C ₃ H ₇ —(H)—(O)	8,00 %		
	FFF CH ₃			
	CCY-3-02	9,00 %		
	CPY-3-02	7,00 %		
	CCY-2-1	8,00 %		
15	CCY-3-1	7,00 %		
	CC-3-V1	13,00 %		
	BCH-32	8,00 %		
20	Beispiel M5			
	CY-5-O2	6,00 %	Klärpunkt [°C]:	84,5
	CCY-3-03	12,00 %	∆n [589 nm, 20 °C]:	0,0852
	CCY-4-02	11,00 %	ε _{li} [1 kHz, 20 °C]:	3,4
	CPY-2-02	10,00 %	Δε [1 kHz, 20 °C]:	-3,1
25	CPY-3-02	5,00 %	_{γ₁} [mPa⋅s, 20 °C]:	110
	CC-4-V	20,00 %	V ₀ [V]:	2,28
	CC-3-V1	9,00 %		
	CCH-34	3,00 %		
	PCH-301	4,00 %		
30	CCH-301	8,00 %		
	$\sim \sim$	12,00 %		
	C ₃ H ₇ —(H)—(CH ₃			
	FF F			

Be	isp	iel	M	6
				_

		•		
	CY-3-O2	14,00 %	Klärpunkt [°C]:	85,0
5	CY-5-O2	6,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,0850
	CCY-3-O2	7,00 %	ε _{II} [1 kHz, 20 °C]:	3,6
	CCY-3-O3	12,00 %	Δε [1 kHz, 20 °C]:	-4,2
	CCY-4-O2	12,00 %	γ₁ [mPa⋅s, 20 °C]:	142
	CPY-2-O2	5,00 %	V ₀ [V]:	2,08
10	CC-5-V	20,00 %	•	
	CC-3-V1	8,00 %		
	CCH-35	6,00 %		
	C_3H_7 H O	10,00 %		
	F F F CH ₃		•	
15	, , ,			
	Beispiel M7			
	CY-3-O2	5,00 %	Klärpunkt [°C]:	83,0
	CCY-3-02	3,00 %	Δn [589 nm, 20 °C]:	0,0837
20	CCY-3-02 CCY-3-03	12,00 %		3,5
	CCY-4-02	10,00 %		-3,8
	CPY-2-02	11,00 %		140
	CC-5-V	20,00 %	V ₀ [V]:	2,03
	CC-3-V1	12,00 %		
25	CCH-35	5,00 %		
	$\sim \sim$	5,00 %		
	C ₃ H ₇ H	0,00 /0		
	FF #			
	CH-(H)-(O)	12,00 %		
30	C4H9 H) FF	•		
	'' r	5 00 °/		
	C ₅ H ₁₁ —H	5,00 %		
	F F F			

Patentansprüche

 Flüssigkristallines Medium auf der Basis eines Gemisches von polaren Verbindungen mit negativer dielektrischer Anisotropie, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine Verbindung der Formel I,

10
$$R^{11}-(A^1-Z^1)_m - (Z^2-A^2)_n-R^{12}$$

worin

15 R¹¹ und R¹²

20

25

30

35

jeweils unabhängig voneinander H, einen unsubstituierten, einen einfach durch CN oder CF₃ oder mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl- oder Alkenylrest mit bis zu 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen durch -O-, -S-,

ersetzt sein können, dass O-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind,

A¹ und A² jeweils unabhängig voneinander

- einen 1,4-Cyclohexenylen- oder 1,4-Cyclohexylenrest, worin eine oder zwei nicht benachbarte CH₂-Gruppen durch -O- oder -S- ersetzt sein können,
- b) einen 1,4-Phenylenrest, worin eine oder zwei CH-Gruppen durch N ersetzt sein können,

c) einen Rest aus der Gruppe Piperidin-1,4-diyl-, 1,4-Bicyclo[2,2,2]-octylen-, einen Naphthalin-2,6diyl, Decahydronaphthalin-2,6-diyl, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2,6-diyl, Phenanthren-2,7diyl, Fluoren-2,7-diyl,

wobei die Reste a), b) und c) ein oder mehrfach durch Halogenatome substituiert sein können,

10

5

jeweils unabhängig voneinander -CO-O-, -O-CO-, -CF $_2$ O-, -OCF $_2$ -, -CH $_2$ O-, -OCH $_2$ -, -CH $_2$ CH $_2$ -, -CH $_2$ CH $_2$ -, -CF=CF-, -CH=CF-, -CF=CH-, -CH=CH-, -C=C- oder eine Einfachbindung, und

15

jeweils unabhängig voneinander 0, 1 oder 2, wobei $m + n \ge 1$ ist,

20 hadaute

enthält.

bedeuten,

m und n

Flüssigkristallines Medium nach Anspruch 1, dadurch gekenn zeichnet, dass es zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formeln IIA und/oder IIB:

$$R^{2} \longrightarrow O \longrightarrow O \cap C_{v} H_{2v+1}$$
 IIA

35
$$R^2$$
 H O (O)C_vH_{2v+1} IIB

worin

 R^2

einen unsubstituierten, einen einfach durch CN oder CF₃ oder einen mindestens einfach durch Halogen substituierten Alkyl- oder Alkenylrest mit bis zu 15 C-Atomen, wobei in diesen Resten auch eine oder mehrere CH₂-Gruppen jeweils unabhängig voneinander durch –O-, -S-, ———, -C=C-,

10

5

-CO-, -CO-O-, -O-CO- oder --O-CO-O- so ersetzt sein können, dass O-Atome nicht direkt miteinander verknüpft sind,

15

p

1 oder 2, und

v

1 bis 6

bedeutet,

20

enthält.

3. Flüssigkristallines Medium nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es zusätzlich eine oder mehrere Verbindungen der Formel III,

25

$$R^{31}$$
 A H R^{32}

30

worin

R³¹ und R³² jeweils unabhängig voneinander einen geradkettigen Alkyl-, Alkenyl-, Alkylalkoxy- oder Alkoxyrest mit bis zu 12 C-Atomen bedeuten, und

bedeuten,

enthält.

5

- 4. Flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es ein, zwei, drei, vier oder mehr Verbindungen der Formel I enthält.
- 10 5. Flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil an Verbindungen der Formel I im Gesamtgemisch mindestens 5 Gew.-% beträgt.
- Flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
 dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil an Verbindungen der Formeln IIA und/oder IIB im Gesamtgemisch mindestens 20 Gew.-% beträgt.
- 7. Flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 20 dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil an Verbindungen der Formel III im Gesamtgemisch mindestens 5 Gew.-% beträgt.
- 8. Flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine Verbindung
 25 ausgewählt aus den Formeln I1 bis I36,

30

$$R^{11}$$
 O $I2$

25

30

$$R^{11}$$
 $Alkyl$ 13

$$R^{11}$$
 O F F F F

$$R^{11}$$
 O Alkyl 15

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F$$

$$I10$$

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F$$
112

$$R^{11}$$
 O Alkyl 113

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F F$$
114

$$R^{11} \longrightarrow 0$$

$$F F F$$

$$I16$$

5
$$R^{11} \longrightarrow F F F$$

$$10$$

$$R^{11} \longrightarrow F F F$$

$$118$$

$$15$$

$$R^{11} \longrightarrow F F F$$

$$119$$

$$20$$

$$R^{11} \longrightarrow F F F$$

$$120$$

$$25$$

$$R^{11} \longrightarrow O \longrightarrow O$$

$$F F F F$$

$$121$$

$$R^{11} \longrightarrow O \longrightarrow Alkyl$$
 123

$$R^{11} \longrightarrow O \longrightarrow Alkyl$$
 129

$$R^{11} \longrightarrow F F F F$$

5
$$R^{11}$$
 O $Alkyl$ $I31$

10 R^{11} O $Alkyl$ $I32$

15 R^{11} O $Alkyl$ $I33$

20 R^{11} O $Alkyl$ $I34$

25 R^{11} O $Alkyl$ $I35$

worin

R¹¹ die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen hat, und Alkyl einen geradkettigen Alkylrest mit 1-6 C-Atomen bedeutet, enthält.

	9.	_	kristallines Medium nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- gekennzeichnet, dass es im wesentlichen aus
5		5-30	Gew% einer oder mehrerer Verbindungen der Formel I.
		und	
10		20-70	Gew% einer oder mehrerer Verbindungen der Formeln IIA und/oder IIB
		besteh	t.
15	10.	rend a	ooptische Anzeige mit einer Aktivmatrix-Addressierung basie- uf dem ECB-, PALC- oder dem IPS-Effekt, dadurch nzeichnet, dass sie als Dielektrikum ein flüssigkristallines m nach einem der Ansprüche 1 bis 9 enthält.
20			· .
25		·	
30			
35			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No EP2004/010648

A. CLASSIF IPC 7	CO9K19/32 CO9K19/42 CO9K19/44	G02F1/13				
	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	on and IPC				
B. FIELDS S	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	symbols)				
IPC 7						
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that suc	ch documents are included in the fields sea	arched			
	ita base consulted during the international search (name of data base					
EPO-Int	cernal, WPI Data, BEILSTEIN Data, CHE	EM ABS Data				
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.			
Υ	WO 03/010120 A (MERCK PATENT GMBH 6 February 2003 (2003-02-06) pages 40-45; claim 3; examples 13		1–10			
А	WO 02/46330 A (MERCK PATENT GMBH) 13 June 2002 (2002-06-13) pages 45-46; claims; examples		1-10			
A	EP 0 637 585 A (HOECHST AG) 8 February 1995 (1995-02-08) page 13		1–10			
A	DE 198 40 447 A (AVENTIS RES & TE CO) 9 March 2000 (2000-03-09) the whole document	CH GMBH &	1-10			
P,Y	WO 2004/048500 A (MERCK PATENT GM 10 June 2004 (2004-06-10) abstract; claims; examples	ВН)	1-10			
Fur	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.			
° Special o	ategories of cited documents:	*T* later document published after the Inte	ernational filing date			
.V. docnu	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	i the application but			
"E" earlier	document but published on or after the International	*X* document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot	n de considereu 10			
"L' document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention						
"O" docum	citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document referring to an oral disclosure, use, exhibition or specified to a person skilled					
P docum	other means Procument published prior to the International filling date but later than the priority date claimed ** document member of the same patent family					
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report			
;	3 January 2005	21/01/2005				
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer				
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fam. (231-70) 340-3016	Kiernan, A				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Informational Application No

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 03010120 A	06-02-2003	DE		A1	30-01-2003
		WO		A1	06-02-2003
		EP	1409441		21-04-2004
		US	2004171866	A1 	02-09-2004
WO 0246330 A	13-06-2002	AU	1392202	A	18-06-2002
## OZ 10000		DE	10155071	A1	08-08-2002
		WO		A1	13-06-2002
		EP	1341871	A1	10-09-2003
		JP	2004522818	T	29-07-2004
		TW	536552	В	11-06-2003
		US	2004036058	A1	26-02-2004
EP 0637585 A	08-02-1995	DE	4326151	A1	09-02-1995
2, 000,000		EP	0637585	A1	08-02-1995
		JP	7070060	Α	14-03-1995
		US	5626791	A	06-05-1997
DE 19840447 A	09-03-2000	DE	19840447	A1	09-03-2000
<i>DE 133.</i> 01		DE	69815139	D1	03-07-2003
		DE	69815139	T2	01-04-2004
		WO	9919420	A2	22-04-1999
		EP	1027403	A2	16-08-2000
		JP	2001520256	T	30-10-2001
		US	6485797	B1	26-11-2002
WO 2004048500 A	10-06-2004	DE	10354404	A1	03-06-2004
		MO	2004048500	Δ1	10-06-2004

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



tremationales A	ktenzeichen
T/EP200	4/010648

A. KLASS IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C09K19/32 C09K19/42 C09K19/4	4 G02F1/13			
Nach der Ir	nternationalen Patentklassilikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK			
	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchie IPK 7	nter Mindestprüfstoff (Massifikationssystem und Klassifikationssymbol C09K	le)			
	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, son				
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)		
EPO-Ir	iternal, WPI Data, BEILSTEIN Data, CH	EM ABS Data			
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	a der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.		
Y	WO 03/010120 A (MERCK PATENT GMBH 6. Februar 2003 (2003-02-06) Seiten 40-45; Anspruch 3; Beispie		1–10		
A	WO 02/46330 A (MERCK PATENT GMBH) 13. Juni 2002 (2002-06-13) Seiten 45-46; Ansprüche; Beispiel	•	1 -10		
A	EP 0 637 585 A (HOECHST AG) 8. Februar 1995 (1995-02-08) Seite 13		1-10		
A	DE 198 40 447 A (AVENTIS RES & TE CO) 9. März 2000 (2000-03-09) das ganze Dokument	CH GMBH &	1–10		
P,Y	WO 2004/048500 A (MERCK PATENT GM 10. Juni 2004 (2004-06-10) Zusammenfassung; Ansprüche; Beisp		1-10		
	eltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie			
* Besonde *A* Veröff aber	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : lentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Dokument, das ledoch erst am oder nach dem internationalen	"T" Spätere Veröffenllichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kolltdiert, sondern nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist	r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden		
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erschelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden syll veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet					
ausgefühnt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedalum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdalum veröffentlicht worden ist *Auf in hinter aus der Praugken Veröffentlichung mit eher oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *Auf in hinter aus der Praugken Veröffentlichung mit eher oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *Auf in hinter aus der Praugken Veröffentlichung mit eher oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *Auf in hinter aus der Praugken Veröffentlichung mit eher oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung die veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung die verbindung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung die verbindung die verbindung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und dieser Verbindung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und dieser Verbindung die verbindung die verbindung die verbindung die verbindung die verbindung die verbindung dieser Kategorie in Verbindung die verb					
	s Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Re	echerchenberichts		
	3. Januar 2005	21/01/2005	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäische Patentiam, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bediensteler			
	NL - 2280 HV Pilswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fav. (431-70) 340-3016	Kiernan, A			

INTERNATIONALER RECHERCHEMBERICHT

Angaben zu Veröffent ___ngen, die zur selben Patentfamilie gehören

in mationales Aktenzeichen T/EP2004/010648

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO 0	3010120	A	06-02-2003	DE WO EP US	10135499 03010120 1409441 2004171866	–	30-01-2003 06-02-2003 21-04-2004 02-09-2004
WO 0	246330	A	13-06-2002	AU DE WO EP JP TW US	1392202 10155071 0246330 1341871 2004522818 536552 2004036058	A1 A1 A1 T B	18-06-2002 08-08-2002 13-06-2002 10-09-2003 29-07-2004 11-06-2003 26-02-2004
EP 0	637585	A	08-02-1995	DE EP JP US	4326151 0637585 7070060 5626791	A1 A	09-02-1995 08-02-1995 14-03-1995 06-05-1997
DE 1	9840447	A	09-03-2000	DE DE DE WO EP JP US	19840447 69815139 69815139 9919420 1027403 2001520256 6485797	D1 T2 A2 A2 T	09-03-2000 03-07-2003 01-04-2004 22-04-1999 16-08-2000 30-10-2001 26-11-2002
WO 2	2004048500	Α	10-06-2004	DE WO	10354404 2004048500		03-06-2004 10-06-2004